変調プラズマを用いた超高硬度ナノ結晶ダイヤモンド膜の作製

兵庫県立大学大学院 工学研究科 機械工学専攻

田中一平

研究背景

カーボンニュートラルの実現に向け、工作機械や自動車などの機械部品に不可欠なしゅう動部分の低損失・長寿命が必須となる。ダイヤモンドは高硬度および低摩擦、高耐摩耗性などの優れた特性を持ち、コーティング材として幅広い分野に応用されているが、しゅう動部品等へのダイヤモンド膜の適用には研磨した後に使用するなど成膜後の後処理に多くの時間とコストが必要である。

ダイヤモンド膜の合成技術として $\text{CH}_4\text{—H}_2$ ガスを原料ガスに用いるマイクロ波プラズマ CVD 法が広く利用されており、低炭素濃度では高品質なダイヤモンド膜が得られるが、結晶粒径が μm オーダーのため表面の凹凸が問題となる。近年では、ナノ結晶ダイヤモンド (NCD) と呼ばれる粒径が 100 nm 未満で構成された NCD 膜が高炭素濃度での合成により得ることができ、平滑なダイヤモンド膜も実現されている。しかし、平滑な NCD 膜は、ダイヤモンド膜と比較して非ダイヤモンド成分を含む結晶粒界が多く存在するために硬度および膜質が低下し、耐摩耗性の向上が課題となっている。

現在トレードオフとなっている膜質と耐摩耗性の関係を両立する平滑なダイヤモンドが得ることができれば、低摩擦かつ高耐摩耗な NCD 膜としてしゅう動部材に適用することが可能になる。

研究目的

本研究では結晶粒径を 100 nm 未満に抑えた低摩擦かつ高耐摩耗なダイヤモンド膜の作製を目的に、マイクロ波プラズマ CVD 法によるダイヤモンド合成時のプラズマ変調を用いたダイヤモンドの成長制御手法を確立する。

成果内容

ダイヤモンドの合成にはマイクロ波プラズマ CVD 装置を用いた。(図1) 本手法は CH_4 — H_2 系反応ガスをマイクロ波によってプラズマにすることでプラズマ直下に設置された基板の上にダイヤモンド膜を合成できる。 CH_4 および H_2 はマスフローコントローラによって流量を制御し、マスフローコントローラはマイコンを介して PC に接続することで PC 制御可能である。合成は図2に示すように、ダイヤモンド合成中の CH_4 ガス流量を連続的に変化させ、 H_2 流量に対する CH_4 流量 (CH_4 濃度) を高炭素濃度プラズマによるナノ結晶ダイヤモンドの核生成をする 10% と低炭素濃度プラズマによる高品質ダイヤモンドの成長させる 1% を 2—5 分間隔で変調させることで高硬度かつ高品質な NCD 膜の成長を行った。加えて、プラズマの発光状態を分光器により発光分光測定し、合成中の発光種を随時測定するシステムを構築した。

図1 実験装置の概略図

図2 変調および成長の概念図

図3にCH₄濃度1%および10%の合成中の発光スペクトルを示す。MCDが合成されるCH₄濃度1%およびNCDが合成されるCH₄濃度10%ではいずれもH α およびH β 、CH、C₂が確認される。この中でH α が最も強度が高く、CH₄の分解により生成されるCHやC₂の発光が濃度の違いで強度が変化することがわかる。

図4にCH₄濃度1%および10%、5分ごとの濃度変調プラズマによるダイヤモンド合成中のI_{C₂}/I_{H α} の推移を示す。濃度変調プラズマでは高CH₄濃度でダイヤモンドの核生成、低CH₄濃度でダイヤモンドの成長を行うため、CH₄濃度が10%、1%の順に変調される。CH₄濃度に増加に伴いC₂の発光強度が高くなるため、変調合成中のC₂/H α の強度比(I_{C₂}/I_{H α})をプロットすると、図4のように5分間隔で変化していることがわかる。濃度が切り替わったタイミングで強度比のオーバーシュートが確認されるが、おおむね1%と10%の発光強度比で推移した。

図3 合成中の発光スペクトル

図4 合成中のI_{C₂}/I_{H α} の推移

この構築したシステムを基に5分以下の変調時間の影響について検討した。図5に濃度変調プラズマ(CMD)で2分および5分で合成したダイヤモンド、CH₄濃度1%で合成したMCD、CH₄濃度10%で合成したNCDの表面SEM像およびレーザー顕微鏡画像を示す。濃度変調プラズマ(CMD)で2分および5分で合成したダイヤモンドの表面形態はCH₄濃度10%で合成したNCDと同様の表面を呈し、100nm前後の微細な粒子で構成されている。レーザー顕微鏡画像でも同様に濃度変調プラズマによって合成したダイヤモンドは表面の起伏が小さく、CMD5の表面粗さSaはNCDと比べて高い値を示したが、MCDと比べて1/5以下の値を示し、CMD2の表面粗さSaはNCDと同等の11nmを示した。また、これらのダイヤモンドのナノインデンテーション試験による硬さは、MCD>CMD5>CMD2>NCDの序列となり、CMD2の硬さは65GPaとMCDの71GPaと同等の硬さを示した。これより、変調時間を短くすることで表面の平滑性と硬さの両立が可能であることが明らかになった。

図5 濃度変調プラズマ (CMD) で2分および5分で合成したダイヤモンドおよびCH₄濃度1%で合成したMCD、CH₄濃度10%で合成したNCDの表面SEM像 (SEM像中左下には硬さ) およびレーザー顕微鏡画像 (左下にはSa)

これらのダイヤモンドの摩擦係数をボールオンディスク型摩擦試験機により測定した。相手材にはアルミナボールを用い、荷重を1Nで試験した。図6に各ダイヤモンド膜の摩擦係数の推移を示す。CMD2の摩擦係数は摩擦試験開始後1000回程度で0.1程度に減少し、その後18000回まで安定した値を示した。一方、CMD5はNCDと同様の摩擦係数の推移を示し、摩擦回数

図6 各ダイヤモンド膜の摩擦係数の推移

18000回付近では0.25程度の摩擦係数を示した。以上のことからCMD2の摩擦係数は最も低い値を示し、変調時間を変化させることで低摩擦係数を示すことが明らかになった。

まとめ

本研究では結晶粒径を100 nm未満に抑えた低摩擦かつ高耐摩耗なダイヤモンド膜の作製を目的に、マイクロ波プラズマCVD法によるダイヤモンド合成時のプラズマ変調の影響について検討した結果、変調時間を2分にするだけで表面粗さはNCDと同等であり、硬さはMCDと同等のダイヤモンド膜を得ることが可能であった。加えて、その摩擦係数は低く、低摩擦係数を示すことが明らかになった。

謝辞

本研究をおこなうにあたり、研究助成していただきました公益財団法人川西記念新明和教育財団の皆様には深く感謝申し上げます。

成果発表

学術論文

大西亮多, 田中一平, 川口夏樹, 原田泰典, CH₄濃度変調プラズマを用いたナノ結晶ダイヤモンド膜の合成, 砥粒加工学会誌, 68, 7, (2024), 399-403.

学会発表

1. Ryota Ohnishi, Harada Yasunori, Tanaka ippei, Kawaguchi Natuki, Mechanical Properties of Diamond Synthesized by Modulating the CH₄ Concentration, International Tribology Conference Fukuoka 2023 2023年9月26日
2. 大西亮多, 田中一平, 川口夏樹, 原田泰典, CH₄濃度変調式マイクロ波プラズマCVDを用いたナノ結晶ダイヤモンド膜の合成, 第9回材料WEEK 材料シンポジウム 「若手学生研究発表会」 2023年10月10日
3. Ryota Ohnishi, Ippei Tanaka, Natuki Kawaguchi, Yasunori Harada, Effect of CH₄ Concentration Modulation on Diamond Films Prepared by Microwave Plasma CVD, 28th IFHTSE Congress in YOKOHAMA 2023年11月15日
4. 大西亮多, 田中一平, 川口夏樹, 原田泰典, マイクロ波プラズマCVDにより合成したダイヤモンド膜に及ぼす濃度変調の影響, 令和5年度 関西表面技術フォーラム 2023年11月30日
5. 大西亮多, 田中一平, 川口夏樹, 原田泰典, マイクロ波プラズマCVDにより合成したダイヤモンド膜の摩擦特性に及ぼす濃度変調の影響, 第149回表面技術協会講演大会 講演 2024年3月5日
6. Ryota Ohnishi, Ippei Tanaka, Natsuki Kawaguchi, Yasunori Harada, Effect of Concentration Modulation on Friction Characteristics of Microwave Plasma CVD Synthesized Diamond Films, The 11th Advanced Forum on Tribology 2024, Himeji 2024年4月15日
7. 大西亮多, 田中一平, 川口夏樹, 原田泰典, マイクロ波プラズマCVDにより作製したダイヤモンド膜に及ぼす濃度変調の影響, 日本材料科学会 2024年度学術講演大会 2024年5月23日